



	<h2 style="color: red;">FQD17P06TM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQD17P06TM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 12A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD17P06TM.pdf 2.FQD17P06TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 70366 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD17P06TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 12A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	70366 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 44W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	135 mOhm @ 6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	900pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD17P06TM ist neu im Original, Suche FQD17P06TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD17P06TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD17P06TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD17N10 F FQD17N10 F</p>	 <p>FQD18N20 Fairchild/ON Semiconductor FQD18N20 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD17P06TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 12A DPAK</p>	 <p>FQD17P06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 12A DPAK</p>
 <p>FQD17P06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 12A DPAK</p>	 <p>FQD18N20V2TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 15A DPAK</p>	 <p>FQD18N20V2 FAIRCHILD FQD18N20V2 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD18N20V2TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 15A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD13N10LTF	↔ FQD13N10LTF	⇒ FQD13N10LTM	D FQD13N10LTM	⇒ FQD13N10LTM-NL
⊣ FQD13N10TM	⊗ FQD13N10TM	D FQD13N20D	⇒ FQD14N15	⇒ FQD16N15
⊗ FQD16N25C	⊣ FQD16N25CTM	⊗ FQD16N25CTM	↔ FQD16N25L	⇒ FQD17N08
D FQD17N08L	⊗ FQD17N08LTF	⊣ FQD17N08LTF	⊗ FQD17N08LTM	⇒ FQD17N08LTM
⇒ FQD17N10	↔ FQD17P06	⊗ FQD17P06TF	⊣ FQD17P06TF	⇒ FQD17P06TM
↔ FQD18N20V2	⇒ FQD18N20V2TM	D FQD18N20V2TM	⊗ FQD19N10	⊣ FQD19N10L
⊗ FQD19N10LTM	D FQD19N10LTM	⇒ FQD19N10TF	↔ FQD19N10TF	⇒ FQD19N10TM
⊣ FQD19N10TM	⊗ FQD1N50B	↔ FQD1N50TF	⇒ FQD1N50TF	⇒ FQD1N60C
⊗ FQD1N60CTF	⊣ FQD1N60CTF	⊗ FQD1N60CTM	D FQD1N60CTM	⇒ FQD1N60TF
↔ FQD1N60TF	⊗ FQD1N60TM	⊣ FQD1N60TM	⊗ FQD1N80TM	⇒ FQD1N80TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited